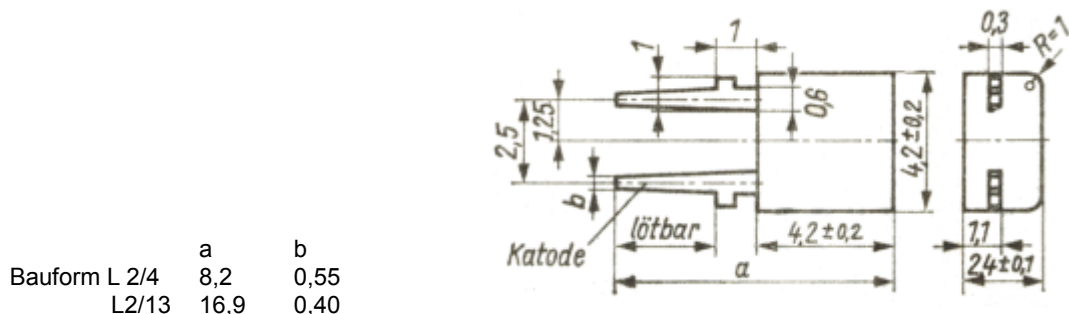


## RFT SAY30 – SAY32 – SAY40 - SAY42

Silizium- Planar- Dioden im Plastikgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF – und HF- Technik, vorzugsweise als mittelschneller und schneller Schalter in Logikschaltungen.

		SAY30	SAY32	SAY40	SAY42
<b>Grenzwerte</b>					
bei $\vartheta_a \leq \vartheta_{max}$					
Sperrspannung	$U_R$	25V	25V	15V	15V
Scheitelsperrspannung	$U_{RWM}$	30V	30V	20V	20V
Durchlaßstrom	$I_F$	30mA	50mA	20mA	30mA
Scheiteldurchlaßstrom	$I_{FWM}$	60mA	100mA	40mA	60mA
Stoßdurchlaßstrom ( $\leq 1s$ , Pause $\geq 2min$ )	$I_{FSM}$	150mA	250mA	100mA	150mA
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j$	125°C	125°C	125°C	125°C
Lagerungstemperatur	$\vartheta_{stg}$	-55°C	-55°C	-55°C	-55°C
	$\vartheta_{stg}$	125°C	125°C	125°C	125°C
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25^\circ C$	$P_{tot}$	150mW	150mW	150mW	150mW
<b>Dynamische Kennwerte</b>					
bei $\vartheta_a = 25^\circ C$					
Nullpunktkapazität bei $U_R = 0V$ , $f=0,5MHz$	$C_O$	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$	$\leq 8pF$
Sperrerrholungszeit	$t_{rr}$	$\leq 65ns^*)$	$\leq 65ns^*)$	$\leq 10ns^*)$	$\leq 10ns^*)$

\*) beim Schalten von  $I_F = 10mA$  auf  $U_R = 6V$ ,  
gemessen bei  $I_R = 1mA$ ;  $R_L = 50 \Omega$



Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985